

本期封面



2002年6期

栏目:

DOI:

论文题目: 插入Bi层对NiFe/Cu/NiFe/FeMn自旋阀多层膜交换耦合的影响

作者姓名: 朱逢吾 于广华 李明华 姜宏伟 赖武彦

工作单位: 北京科技大学材料物理系, 北京100083

通信作者: 朱逢吾

通信作者Email: xps116@263.net

文章摘要: 对于Ta/NiFe/Cu/NiFe/FeMn/Ta自旋阀多层膜, Cu原子偏聚到NiFe/FeMn界面将导致自旋阀多层膜中NiFe/FeMn的交换耦合场Hex下降. 然而, 少量的表面活化原子Bi被沉积到Cu层和被钉扎NiFe层之间, Cu原子在NiFe/FeMn界面的偏聚可以被抑制; 而且, 更重要的是Ta/NiFe/Cu/NiFe/FeMn/Ta自旋阀多层膜中的交换耦合场Hex可以被有效地提高.

关键词: 层间偏聚, 交换耦合场, 表面活化原子Bi, XPS

分类号: TG146.1

关闭